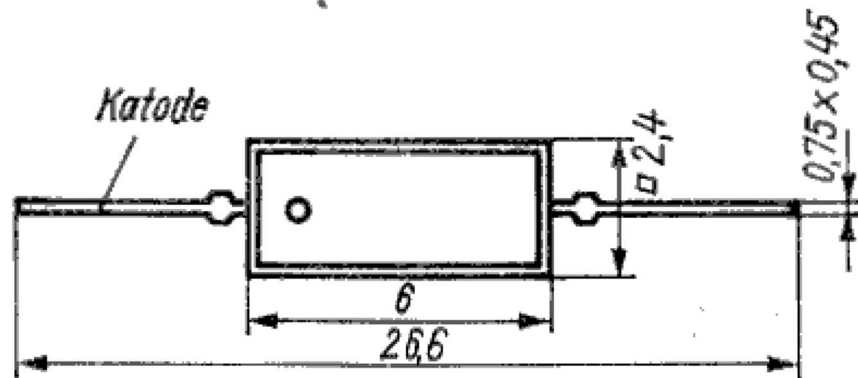


# Silizium-Epitaxie-Diode im Plastgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF- und HF-Technik



## Grenzwerte

Sperrgleichspannung	$U_R$	80 V
Durchlaßgleichstrom	$I_F$	100 mA
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	100 mW
Betriebstemperaturbereich	$\vartheta_a$	$-25 \dots +85^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	$\vartheta_{\text{stg}}$	$-55 \dots +125^\circ\text{C}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j$	125 °C

## Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßgleichspannung bei $I_F = 100\text{ mA}$	$U_F$	$\leq 1,2\text{ V}$
Sperrgleichstrom bei $U_R = 80\text{ V}$	$I_R$	$\leq 0,5\ \mu\text{A}$